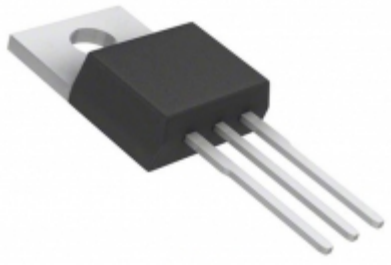



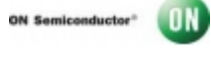




	<h2 style="color: red;">FDP8N50NZ</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDP8N50NZ</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 500V TO-220AB-3</p> <p>Datenblätter: 1.FDP8N50NZ.pdf 2.FDP8N50NZ.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 5337 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
 <p style="text-align: center;">YIC International Co., Limited.</p>	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDP8N50NZ
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V TO-220AB-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	5337 pcs Stock
Serie	UniFET™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	130W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	850 mOhm @ 4A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	18nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	735pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±25V
Verpackung	Tube

FDP8N50NZ ist neu im Original, Suche FDP8N50NZ Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDP8N50NZ Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDP8N50NZ: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDP8896-08 FSC FDP8896-08 FSC</p>	 <p>FDP8N50NZ AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V TO-220AB-3</p>	 <p>FDP8896_F085 FSC FDP8896_F085 FSC</p>	 <p>FDPC1002S AMI Semiconductor / ON Semiconductor INTEGRATED CIRCUIT</p>
 <p>FDPC1002S FAIRCHILD FAIRCHILD QFN</p>	 <p>FDPC4044 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 8MLP</p>	 <p>FDP8D5N10C AMI Semiconductor / ON Semiconductor FET ENGR DEV-NOT REL</p>	 <p>FDPC4044 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 8MLP</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ FDP75N08A	↔ FDP75N08A	⇒ FDP75N80A	D FDP79N15	⇒ FDP79N15
⊣ FDP7N50F	⊗ FDP7N50U	D FDP7N60NZ	⇒ FDP7N60NZ	⇒ FDP8030A
⊗ FDP8030L	⊣ FDP8030L	⊗ FDP80N06	↔ FDP80N06	⇒ FDP8441_F085
D FDP8441_F085	⊗ FDP8442_F085	⊣ FDP8443_F085	⊗ FDP8447L	⇒ FDP8447L
⇒ FDP8870_F085	↔ FDP8874-NL	⊗ FDP8896-08	⊣ FDP8896_F085	⇒ FDP8N50NZ
↔ FDPC1002S	⇒ FDPC1002S	D FDPC5018SG	⊗ FDPC5018SG	⊣ FDPC8013S
⊗ FDPC8013S	D FDPC8016S	⇒ FDPC8016S	↔ FDPF035N06B	⇒ FDPF035N06B_F152
⊣ FDPF041N06BL1	⊗ FDPF041N06BL1	↔ FDPF045N10A	⇒ FDPF045N10A	⇒ FDPF085N10A
⊗ FDPF085N10A	⊣ FDPF10N50FT	⊗ FDPF10N50FT	D FDPF10N50UT	⇒ FDPF10N50UT
↔ FDPF10N60NZ	⊗ FDPF10N60NZ	⊣ FDPF10N60ZUT	⊗ FDPF10N60ZUT	⇒ FDPF12N35

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited